

■シンポジウム一覧

開催日	時間	会場	テーマ	世話人(所属)
3/27 (火)	10:00～17:30	D棟4F-D413 SQ会場(31)	半導体プロセス・デバイス・回路のモデリングとシミュレーション	小田中伸二(阪大)
	13:00～17:00	D棟2F-D212 SB会場(31)	新画像システム研究会企画:「光・画像に基づく本人認証システムの展開」	鈴木 裕之(東工大)
	13:50～17:50	E棟3F-E303 ZQ会場(30)	次世代光ネットワーク実現へ向けた光デバイス・コンポーネントの最近の進展	工藤 耕治(NECシステムデバイス研)
	13:00～17:15	D棟1F-D113 ZW会場(31)	電磁メタマテリアル	岡本 隆之(理研) 梶川浩太郎(東工大)
	13:00～17:15	E棟3F-E305 ZS会場(31)	超伝導分科会企画: 「新展開:超伝導材料技術の革新とパワー・磁場応用最前線」	松本 要(京大)
	13:00～17:20	D棟1F-D114 ZX会場(31)	極高真空技術の科学と応用	荒川 一郎(学習院大)
	13:00～17:20	E棟2F-E202 ZG会場(30)	半導体計測・評価技術 -最先端プロセスからの要求と局所プロービング技術の可能性	金山 敏彦(産総研)
	13:00～17:20	E棟2F-E203 ZH会場(30)	SiON から High-k 絶縁膜の信頼性科学 -実用化に向けた最後の課題-	村岡 浩一(東芝) 渡部 平司(阪大) 山田 啓作(早大)
	13:00～17:30	E棟1F-E102 W会場(30)	多元化合物とナノテクノロジー	脇田 和樹(大府大) 白方 祥(愛媛大)
	13:00～17:35	E棟2F-E201 ZC会場(30)	目前に迫ったデバイス実用化を前に -SiCの完全結晶を求めて-	木本 恒暢(京大) 播磨 弘(京都工繊大)
13:00～17:45	E棟2F-E204 ZL会場(30)	テラヘルツ電磁波技術研究会企画 「テラヘルツ波コンポーネント-基礎と応用展望」	角屋 豊(広島大)	
3/28 (水)	13:00～16:20	E棟1F-E102 W会場(32)	日本学術振興会第161委員会企画 「有機半導体薄膜結晶化の現状:エピタキシャル成長機構と結晶品質」	中嶋 一雄(東北大)
	13:00～17:00	F棟4F-F408 R会場(32)	分光センシング技術の新たな活用と展開	石井 行弘(東理大) 大谷 幸利(農工大) 相津 佳永(室工大)
	13:00～17:10	F棟3F-F307 H会場(32)	「光学設計・製作技術の最新トピックス -国際会議:ODF'06, Naraより-」	小川 育生(NTTフォトンクス研)
	13:00～17:40	D棟3F-D316 SL会場(33)	超伝導検出器による電磁波-X線-生体分子分光計測技術の展望	大久保雅隆(産総研)
	13:00～17:30	E棟2F-E206 ZJ会場(33)	公的研究費を考える -人材育成と国際競争力の視点から-	竹内 淳(早大)
	13:00～17:55	E棟3F-E305 ZS会場(33)	時代が求める分極反転光デバイス	栗村 直(物材機構)
	13:00～17:55	E棟2F-E202 ZG会場(32)	S PMによる液中計測の新展開	杉山 滋(食総研) 古川 一暁(NTT性基礎研)
	13:30～16:55	E棟3F-E303 ZQ会場(33)	シリコンナノエレクトロニクスの新展開 「特性ばらつき解明とナノデバイスインテグリティ」	平本 俊郎(東大生研)
	13:30～17:00	F棟4F-F401 M会場(32)	「リフレッシュ理科教室」開催して10年が経過 -実施状況と抱える問題を考える-	中澤 達夫(長野高専)
	13:30～16:55	E棟2F-E201 ZC会場(32)	有機系原材料におけるプラズマプロセス -低解離・低ダメージプロセスを目指して-	中村 圭二(中部大)
	13:30～17:15	D棟1F-D114 ZX会場(33)	ナノフォトニクスにおける物理現象を考える	川添 忠(科技振) 堀 裕和(山梨大)
	13:30～17:20	D棟1F-D113 ZW会場(33)	ランダム系フォトエレクトロニクスのセレンディビティ	田中 啓司(北大)
14:00～17:00	D棟4F-D407 SN会場(34)	プラズマフォトニクスの幕開けと展開	近藤 公伯(阪大)	
3/29 (木)	9:15～17:05	E棟2F-E202 ZG会場(35)	日本学術振興会第145委員会・第161委員会・第175委員会合同企画 「Siバルク結晶系太陽電池のイノベーション」	柿本 浩一(九大) 宇佐美徳隆(東北大) 山田 明(東工大)
	9:30～17:00	D棟4F-D416 SR会場(35)	自己組織化膜の実用方向とその課題	中嶋 健(東工大) 石田 敬雄(産総研) 松田 直樹(産総研) 橋詰 富博(日立基礎研)
	10:00～16:25	F棟4F-F408 R会場(34)	振動分光で探る生体機能のシグネチャー	井上 康志(阪大院) 藤田 克昌(阪大院)
	10:00～17:45	E棟2F-E201 ZC会場(34)	酸化亜鉛エレクトロニクスの進展と今後の展望	川崎 雅司(東北大)
	13:00～16:50	E棟3F-E301 ZM会場(35)	白色LEDの高性能化に向けた光物性研究最前線	原 和彦(静岡大) 倉井 聡(山口大)
	13:00～17:15	F棟2F-F201 A会場(34)	衝撃応用	松本 仁(防衛大)
	13:10～17:30	E棟3F-E304 ZT会場(35)	さまざまな物質へのスピン注入と関連現象	鈴木 義茂(阪大) 田中 雅明(東大)
	13:30～16:20	E棟2F-E205 ZK会場(35)	エネルギー・環境研究会設立記念シンポジウム 「これからのエネルギー技術を考える」	内田 晴久(東海大) 岸田 俊二(NEC)
	13:30～17:15	E棟1F-E101 V会場(34)	エレクトロニクス有機界面幾何工学	加藤 景三(新潟大) 白井 博明(農工大)
13:35～17:20	E棟1F-E102 W会場(34)	結晶工学分科会企画シンポジウム 「シンクロトン放射光の結晶工学への応用」	水野 章敏(学習院大) 田中 克(NHK) 酒井 朗(名大)	
3/30 (金)	9:35～12:00	F棟2F-F204 B会場(36)	放射能のトレーサビリティとPETの定量化	佐藤 泰(産総研) 山谷 泰賀(放医研)

()内の数字はプログラム掲載頁。

■ 11. 半導体Aシリコン 分科内総合講演 「LSI 多層配線に関するプロセス・信頼性メカニズムと最先端技術」(招待講演)

開催日	時間	会場	テーマ	講演者(所属)
3/28 (水)	10:00~10:10	ZL会場 E棟 2F-E204(88)	イントロダクトリトーク: 次世代多層配線開発とメカニズム	林 喜宏 (N E C)
	10:10~10:40		密度変調 Low-k 膜を用いた 32nm 世代対応 Cu 配線技術	多田 宗弘 (N E C)
	10:40~11:10		Porous low-k 膜を用いた 45nm 世代 CuULK インテグレーション	香川 恵永 (ソ ニ ー)
	11:10~11:40		最先端光配線技術	大橋 啓之 (N E C)
	11:40~12:10		『ユニットプロセスメカニズム』 Ti 膜適用による Cu-BM 酸化耐性の向上	蓮沼 正彦 (東 芝 セ ミ コ ン 社)
	13:10~13:40		『ユニットプロセスメカニズム』 LSI 微細配線埋込銅めっき技術	赤星 晴夫 (日 立)
	13:40~14:10		『ユニットプロセスメカニズム』 「陽電子ビームによる Cu/Low-k 材料の空孔分析」	大平 俊行 (産 総 研)
	14:25~14:55		『配線信頼性メカニズム』 配線信頼性: Cu-SIV メカニズム	中村 友二 (富 士 通 研)
	14:55~15:15		『配線信頼性メカニズム』 Ultra low-k 膜 (k=2.0) 及び選択的バリア層 CuSiN を適用した 32nm 世代向け Cu 配線技術	林 裕美 (東 芝 セ ミ コ ン 社)
	15:15~15:45		『配線信頼性メカニズム』 TDDB 信頼度: 層間絶縁膜中の Cu イオン・ドリフト機構	武田 健一 (日 立)
15:45~16:15	『配線信頼性メカニズム』 「アセンブリ応力によるトランジスタ特性変動定量化技術と応力緩和構造」	竹村 康司 (松 下 電 器)		

■ 14. 非晶質・微結晶 分科内総合講演 「Cat-CVD 法の現状と今後の展開」(招待講演)

開催日	時間	会場	テーマ	講演者名(所属)
3/29 (木)	9:30~10:00	X会場 E棟 1F-E103 (108)	イントロダクトリトーク: Cat-CVD 法の現状と今後の展開	松村 英樹 (北 陸 先 端 大)
	10:00~10:30		Cat-CVD 法によるナノ結晶材料の作製	宮島 晋介 (東 工 大)
	10:30~11:00		Cat-CVD 法による窒化物半導体の成長	安井 寛治 (長 岡 技 科 大)
	11:15~11:45		Cat-CVD 法による酸化物材料の作製	荻田陽一郎 (神 奈 川 工 科 大)

■ 5 光エレクトロニクス 分科内招待講演

開催日	時間	会場	テーマ	講演者(所属)
3/27 (火)	13:00~13:45	SG会場 D棟 2F-D214(53)	光通信デバイス用 MEMS ミラー	佐脇 一平 (富 士 通 研)
3/28 (水)	13:00~13:45	SG会場 D棟 2F-D214(52)	量子カスケードレーザの現状と将来展望	山西 正道 (浜 松 ホ ト ニ ク ス)
3/29 (木)	12:30~13:15	SG会場 D棟 2F-D214(53)	単一走行キャリア・フォトダイオードをベースとした超高速光・電子融合デバイス	伊藤 弘 (N T T)
3/29 (木)	15:15~15:45	SG会場 D棟 2F-D214(53)	近接場光学の次世代光記録への展開	富永 淳二 (産 総 研)
3/30 (金)	10:50~11:20	SG会場 D棟 2F-D214(55)	高速光クロックトランジスタアレイとその非同期光パケット処理への応用	浦田 涼平 (N T T)

■ 6 薄膜・表面 分科内招待講演

開催日	時間	会場	テーマ	講演者(所属)
3/28 (水)	13:30~14:10	SV会場 D棟 4F-D415(56)	PZT 圧電薄膜型 MEMS デバイスの開発と振動ジャイロへの展開	野村 幸治 (パ ナ ソ ニ ッ ク)
3/29 (木)	13:30~14:10	SV会場 D棟 4F-D415(57)	低消費電力、セキュア用途で伸びる F R A M 市場と展望	田中 均 (富 士 通)

■ 10 有機分子・バイオエレクトロニクス 分科内招待講演

開催日	時間	会場	テーマ	講演者(所属)
3/28 (水)	9:00~9:30	ZG会場 E棟 2F-E202(84)	ペプチドの集合体による材料合成とデバイス作製: バイオナノテクノロジーによるアプローチ	松井 宏 (ニ ュ ー ヨ ー ク 市 立 大)

■ 12 半導体 B (探索的材料・デバイス) 分科内招待講演

開催日	時間	会場	テーマ	講演者(所属)
3/27 (火)	14:00~14:30	SM会場 D棟 3F-D315(95)	高周波半導体材料・デバイス技術の研究動向	佐野 芳明 (沖 電 気)
3/29 (木)	10:30~11:00	T会場 F棟 4F-F405(94)	表面弾性波による動的閉じ込め量子構造の光物性制御およびその応用	寒川 哲臣 (N T T)
3/30 (金)	9:00~9:30	ZN会場 E棟 3F-E302(99)	無機 EL 技術を用いた FP-TV の実現に向けて	浜田 弘喜 (三 洋 電 機)

■ 合同セッション F 「カーボンナノチューブの基礎と応用」 分科内招待講演

開催日	時間	会場	テーマ	講演者(所属)
3/28 (水)	13:30~14:00	ZR会場 E棟 3F-E307 (115)	マイクロ・ナノ電気機械による高感度センシングとナノプロセッシング	小野 崇人 (東 北 大)

■ 光学論文賞受賞記念講演

開催日	時間	会場	テーマ	講演者(所属)
3/28 (水)	13:45~14:25	Y会場 E棟 1F-E106(41)	プラズモニック・メタマテリアルの光伝搬制御素子への応用	田中 拓男 (理 研)
	14:25~15:05		Coherence vortices, coherence current, and the conservation laws in coherence dynamics	Wei Wang (電 通 大)